

カップホルダ

特 許 No 5721657

発明者 小玉易広, 福井直行, 中野大一郎*¹, 横田 誠*¹

[発明の属する技術分野]

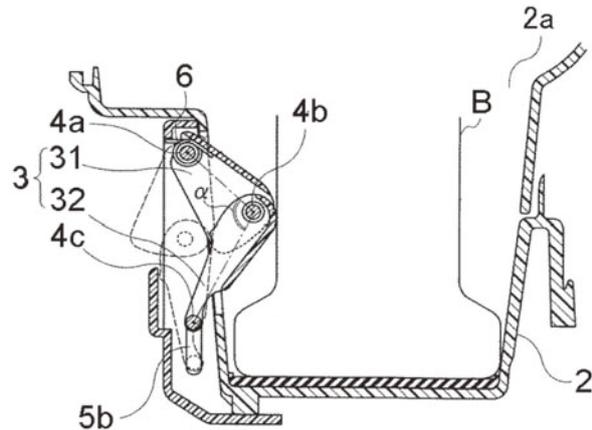
本発明は、飲料容器等を安定状態で保持するためのカップホルダに関する。

[発明の概要]

本体の収納部 2a へバネ 6 により突出し容器 B を支持する支持部材 3 は、上端が本体 2 に回転中心 4a で連結された第一支持片 31 と、その下端に上端が回転中心 4b で連結された第二支持片 32 とからなり、本体 2 には第二支持片 32 下端の回転中心 4c を案内・規制する規制部材 5b が設けられており、各回転中心 4a, 4b, 4c を結ぶ直線のなす角度 α が鈍角となっているカップホルダ。

[発明の効果]

側面に凹凸形状を有する容器 B でも、収納部 2a から円滑に取り出すことができる。



*¹ 株式会社コジマ (本特許は同社との共同出願)

ガラスラン

特 許 No 5130658

発明者 高瀬智宏, 岩佐則正, 有竹祐則, 土岐 智

[発明の属する技術分野]

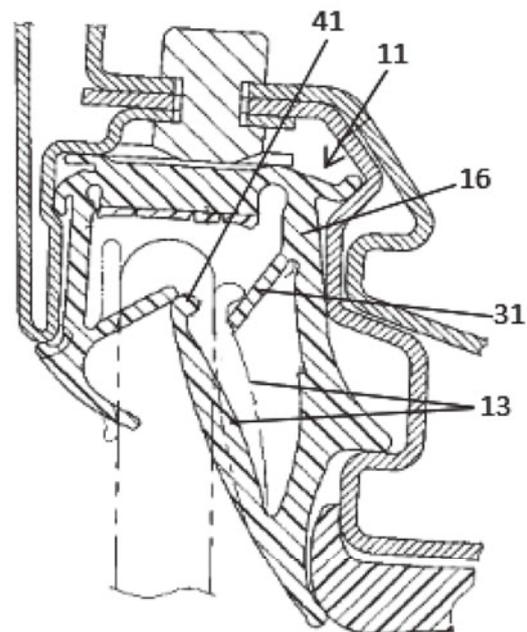
本発明は、自動車のガラス開口部周縁に取付けられるガラスランに関する。

[発明の概要]

ガラスランの少なくとも縦辺部を構成する部位の車内側側壁 16 には、本体部 11 の内側に向けてガラス開口部内周側に傾斜しつつ延び、先端部において車内側シールリップ 13 と接触可能に設けられたサブリップ 31 が設けられている。車内側シールリップ 13 には、サブリップ 31 の先端と最初に接触する部位よりも先端部側において、車内側側壁部 16 側に突出する規制突起 41 が設けられている。規制突起 41 の突出長は、サブリップ 31 の厚みの 0.5 倍以上 1.8 倍以下に設定してある。

[発明の効果]

ドアガラスが車内側に変位しようとした場合、車内側シールリップ及びサブリップが協働してドアガラスを支持することで、ドアガラスのたつきを抑制することができる。



燃料供給装置

特 許 No 5321444

発明者 関原敦史, 加藤哲史, 三吉啓司, 平松義也
[発明の属する技術分野]

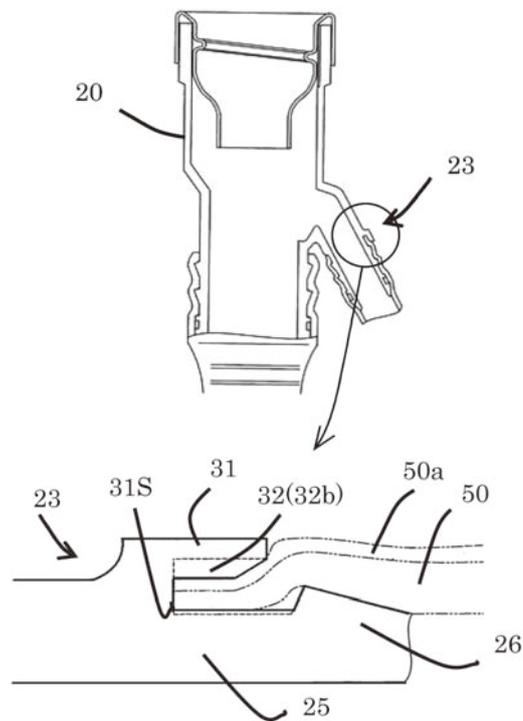
本発明は, 燃料パイプとアース経路を構成する燃料供給装置に関する。

[発明の概要]

燃料供給装置は, パイプ接続部 23 を有するファイラネック 20 と, 導電性の外層 50a を有する燃料パイプ 50 とを有する。パイプ接続部 23 は, 拔止突起 26 と, アース接続部 31 とを備える。アース接続部 31 は, 断面ほぼ L 字形に突設され, 接続本体 25 の外周面との間で挿入間隙 31S を形成する押圧部 32 を有する。押圧部 32 の接続用突起 32b は, 挿入間隙 31S に圧入された燃料パイプ 50 の外層を押圧する。

[発明の効果]

アース接続部の押圧部の接続用突起が, 燃料パイプの導電性の外層に食い込むことで, 電氣的接続を確実に行う。



インフレーター製造方法

特 許 No 5098841

発明者 浅沼準一, 榎谷宜孝, 森 圭介, 荒木 孝
[発明の属する技術分野]

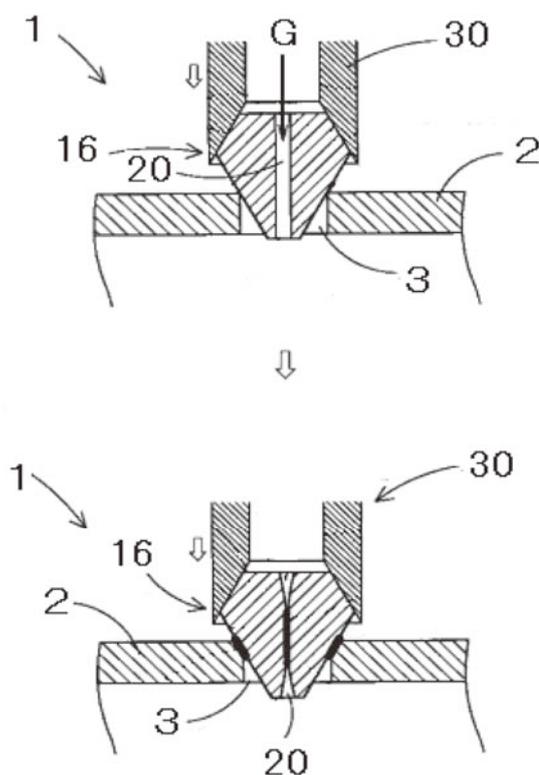
本発明は, エアバッグ膨張用のガスが充填されたインフレーター製造方法に関する。

[発明の概要]

インフレーター 1 のハウジング 2 壁面の開口 3 に, 流路 20 を設けた閉塞体 16 を, 充填ノズル 30 で押し当て, 充填ノズル 30 から加圧ガス G を流路 20 を経てハウジング 2 内に充填する。次いで, 充填ノズル 30 から閉塞体 16 を介してハウジング 2 に電流を通电して, 流路 20 の内周面を抵抗溶接すると同時に閉塞体 16 をハウジング 2 の開口 3 の周縁に溶着固定する。

[発明の効果]

充填ノズルを加圧ガスの充填と閉塞体への通电に併用することでインフレーターを容易かつ安価に製造することができる。



Ⅲ 族窒化物半導体発光素子およびその製造方法

特 許 No 5668647

発明者 宮崎敦嗣, 奥野浩司, 新田州吾

[発明の属する技術分野]

本発明は、p型層の形成方法に特徴を有したⅢ族窒化物半導体発光素子の製造方法であり、特にpクラッド層の特性悪化を防止することができる製造方法に関する。

[発明の概要]

発光層の上に、Alを含有する窒化物半導体からなるpクラッド層を形成し、その上に、同温でノンドープもしくはMg濃度が $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以下でGaNまたはInGaNからなるキャップ層を形成し、昇温後、pコンタクト層を形成する。

[発明の効果]

pクラッド層の特性悪化が防止されるため、発光効率の向上や素子の信頼性向上などを図ることができる。

